



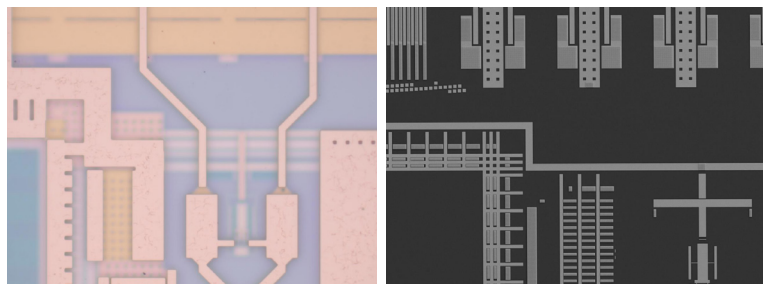
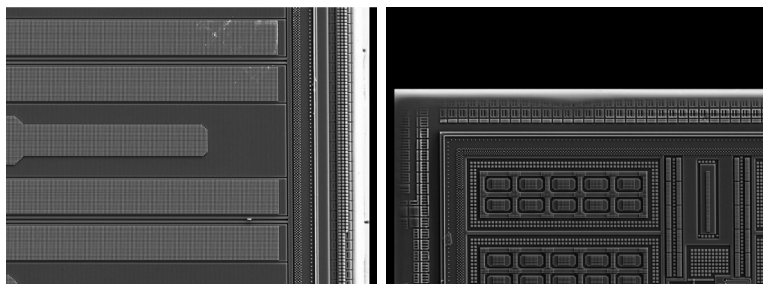
Установка реактивного ионного травления TFA100E-RIE

УСТАНОВКА РЕАКТИВНОГО ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ TFA100E-RIE

Установка предназначена для реактивного ионного травления пассивирующих слоев (SiO_2 , SiN_x), адгезионных слоев (TaN), травления кремния с обратной стороны, травления вольфрама в отверстиях и других процессов.

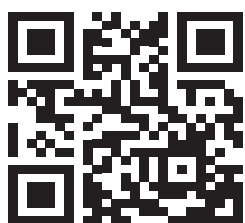
Установка обеспечивает высокую скорость травления материала, высокий коэффициент селективности травления, не допускает перегрев образцов.

Модель позволяет получать микро- и наноструктуры, поддерживает различные размеры образцов.



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая скорость травления
- Высокая селективность
- Подходит для образцов различных размеров
- Полностью автоматизированный процесс
- Возможность регулировки параметров процесса: давления, мощности плазменного источника, расхода рабочих газов

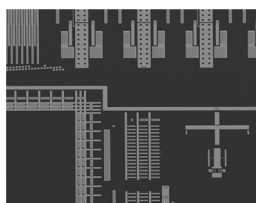


+7 (499) 398-0770
www.akmicrotech.ru
sales@akmicrotech.ru

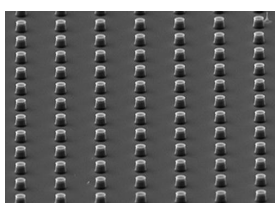
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ РЕАКТИВНОГО ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ TFA100E-RIE

Макс. размер пластин/подложек	4", 8", 12" (другие размеры - по запросу)
Скорость травления	50 - 150 нм/мин
Шероховатость поверхности после травления	<1 нм
Коэффициент селективности	Cu/Al: > 50
Мощность RF плазменного источника	300 / 500 / 1000 Вт
Количество газовых линий	до 9 шт.
Система откачки	Турбомолекулярный насос, форвакуумный насос
Давление в камере	0 ~ 1 Торр
Габаритные размеры	1300 мм x 750 мм x 950 мм

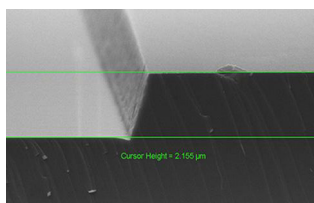
ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



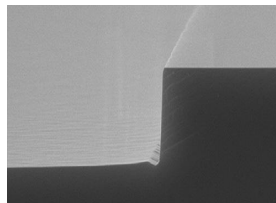
Травление
пассивирующих слоев



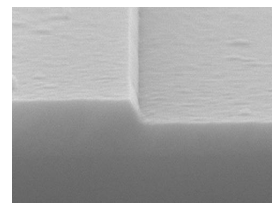
Травление
кремния



Травление
карбида кремния



Травление
фосфида индия



Травление
кварца

СЕРИИ И МОДИФИКАЦИИ



Установка индуктивно
связанного плазменного
травления



Установка ионно-лучевого
травления